



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique



UNIVERSITE MOHAMED KHIDER DE BISKRA
FACULTE DES SCIENCES ET DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

N° d'ordre:.....

Série:.....

Mémoire

Présenté pour obtenir le diplôme de Magister nouveau régime en

Physique

Option

Physique des semi-conducteurs et Matériaux Métalliques

-Thème-

**Modélisation Quantique d'un Transistor à Effet de
Champ Hétéro-Jonction à Base SiGe par la Méthode
des Volumes Finis**

Par

LAZNEK Samira

Soutenu le :/...../2005

Devant le jury

Président	: Dr. M. BAHRI.	MC	Univ. Biskra
Rapporteur	: Dr. S. M. MIMOUNE	MC	Univ. Biskra
Examineurs	: Dr. A. EL AKRMI	Pr	Univ. Annaba
	Dr. N. SENGOUA.	MC	Univ. Biskra
	Dr. K. SRAIRI	MC	Univ. Biskra

Année Universitaire 2004/2005